

酸化膜工程向け CMPスラリー

ILD™シリーズ

ILD™シリーズはヒュームドシリカを用いた酸化膜CMPスラリーです。
一般的なコロイダルシリカスラリーでは実現困難な高研磨レートと
スクラッチフリー・不純物金属低減を実現した業界標準品です。

概要

- 低スクラッチ性能が求められる酸化膜工程研磨に最適
- KOH/アンモニアベース
- 圧倒的な不純物金属低減
- 高い機械研磨特性



	ILD3013	ILD3225
主成分	ヒュームドシリカ	
ケミカル	アンモニア	KOH
砥粒濃度 (wt%)	13.7	25.7
pH	10.5	11.0
砥粒サイズ(nm)	85	
粘度 (cP)	1.8	3.7
比重	1.08	1.17
標準希釈倍率	原液使用タイプ	2倍希釈タイプ

	特長
ILD3013	・安定したスクラッチ性能と不純物金属低減を兼備 ・アンモニアベースの為、安全性が高い
ILD3225	・独自の優れた分散・分級技術により、粘度、粒子径、粗大粒子数が他社品と比較して低減 ・残パーティクル低減に貢献

※その他、本カタログ掲載以外の各種スラリーを数多く取り揃えていますので、お気軽にご相談ください。

梱包形態

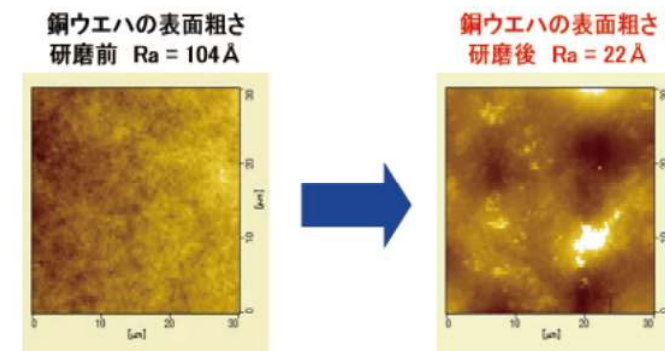
20ℓ ペールの高純度薬品用グレードのクリーン容器に充填された状態
でお届けいたします。ドラム、コンテナ、少量容器のご用意もございます。



厚膜Cu向け CMPスラリー

NP1000MS

NP1000MSはミクロンオーダーの厚膜Cuの除去を目的としています。
MEMSなどの配線材や部品としてメッキされた厚膜Cu、パッケージ基板のCuに対して高速除去が可能です。
使用時には過酸化水素水を添加してからお使いください。



※SI製 SPA465にて測定

	NP1000MS
主成分	高純度コロイダルシリカ
砥粒濃度(wt%)	10.6
pH	2.0
砥粒サイズ(nm)	70
標準希釈倍率 (重量換算)	NP1000MS : 30%H ₂ O ₂ =100 : 76.5
特長	高研磨レート 段差緩和性に優れる

バリアメタル向け CMPスラリー

ACuPLANE™

Cu-CMPにおいてTaやTa₂N等のバリアメタルの除去を目的
として開発されました。
高い製品安定性、高速バリア除去、低圧研磨性を兼備した
高性能スラリーです。
使用時には過酸化水素水を添加してからお使いください。

	ACuPLANE™ LK393c4
主成分	コロイダルシリカ
pH	10.4
砥粒濃度(wt%)	14.8
砥粒サイズ(nm)	50
粘度 (cP)	1.5
標準添加量 (重量換算)	LK393c4 : 30%H ₂ O ₂ =74 : 1
特長	研磨レート調整可能 低欠陥性

タングステン配線向け CMPスラリー

NOVAPLANE™1000

デバイスのタングステン配線研磨に効果的なスラリーです。
高希釈倍率でありながら、高いタングステン研磨レートが得られます。
スループットの改善及び希釈によるユースポイントでのスラリーコスト
の低減に貢献します。

	NOVAPLANE™1000
主成分	ヒュームドシリカ
pH	3.0
固形分 (%)	1.0
砥粒サイズ(nm)	130
比重	1.008
標準希釈倍率	3~5倍希釈タイプ
特長	1液性 高選択 タングステンに対しての 高研磨レート

※その他、本カタログ掲載以外の各種スラリーを数多く取り揃えていますので、お気軽にご相談ください。